

Silicon Diode

BY269

1600V / 0,8A

DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1988

BY 268 · BY 269

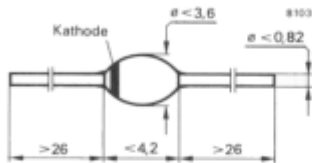
Silizium-Mesa-Dioden

Anwendungen: Hochspannungsgleichrichter

Besondere Merkmale:

- Glaspassivierte Sperrschicht
- Hermetisch dichtes Gehäuse

Abmessungen in mm



Sinterglasgehäuse
SOD 57
Gewicht max. 0,5 g

Bestempfung: Klartext

Absolute Grenzwerte

		BY 268	BY 269	
Spitzensperrspannung	U_{RSM}	1600	1800	V
Sperrspannung	U_R	1400	1600	V
Stoßdurchlaßstrom $t_p = 10 \text{ ms}$	I_{FSM}	20		A
Durchlaßstrom, Mittelwert	I_{FAV}	0,8		A
Sperrschichttemperatur	T_j	175		°C
Lagerungstemperaturbereich	T_{stg}	- 65.....+ 175		°C

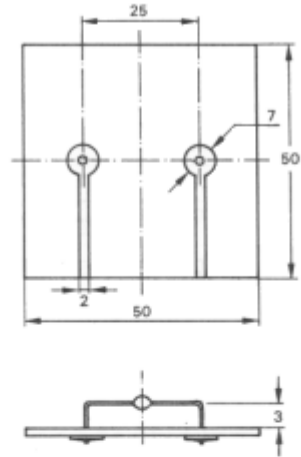
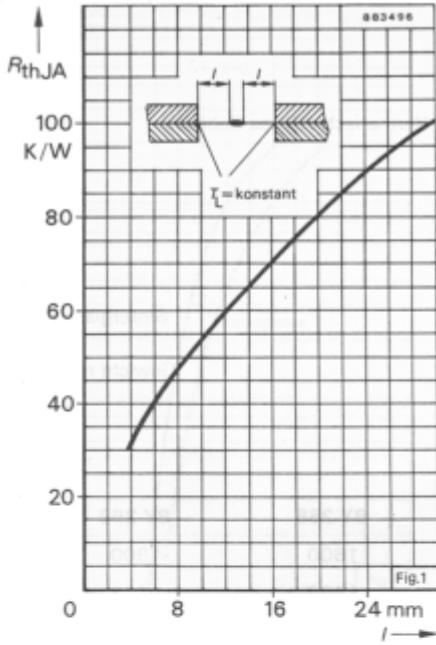
Maximaler Wärmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung auf Leiterplatte im Raster 25 mm	R_{thJA}	110		K/W
---	------------	-----	--	-----

Kenngrößen

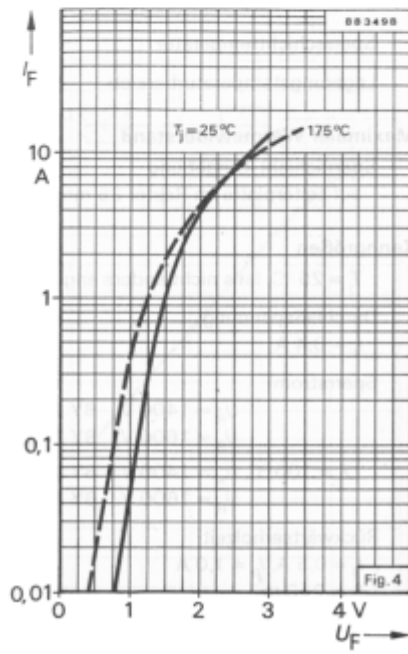
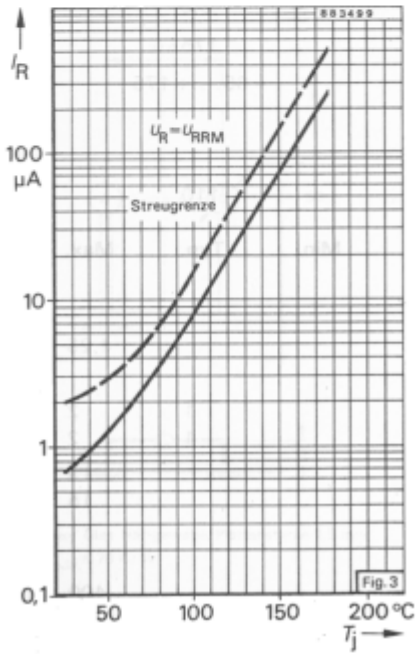
		Min.	Typ.	Max.	
$T_j = 25 \text{ °C}$, falls nicht anders angegeben					
Durchlaßspannung $I_F = 0,4 \text{ A}$	U_F			1,25	V
Sperrstrom	$U_R = 1400 \text{ V}$ BY 268		1	2	μA
	$U_R = 1600 \text{ V}$ BY 269		1	2	μA
$T_j = 100 \text{ °C}$, $U_R = 1400 \text{ V}$	BY 268			15	μA
	$U_R = 1600 \text{ V}$ BY 269			15	μA
Rückwärtserholzeit $I_F = 0,5 \text{ A}$, $I_R = 1,0 \text{ A}$ $I_R = 250 \text{ mA}$	t_{rr}			400	ns

BY 268 · BY 269



Epoxy Glas Hartgewebe, Plattenstärke: 1,5 mm
 $R_{th,JA} \leq 110 \text{ K/W}$

Fig. 2 88 3497



BY 268 · BY 269